

CMOS 模拟集成电路原理 第五周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期: 2020 年 10 月 12 日

目录

1 作业内容	1
2 系统性失调	2
3 随机性失调	2
4 电路搭建	2
5 系统性失调验证	2
6 随机性失调验证	4
7 CMRR 验证	4

List of Figures

1 作业电路	1
2 扫描 pMOS 长宽比电路	2
3 扫描 pMOS 长宽比 MDE 设置	3
4 OTA (未进行单位增益缓冲) 各管状态以及电流大小	3
5 单位增益负反馈电路	3
6 系统性失调转换到输入端为 $97\mu V$	4
7 蒙特卡洛仿真	4
8 OTA 共模增益	4
9 OTA 差分增益	5

1 作业内容

对一偏置电流为 $100\mu A$ 的五管 OTA, 共模电压为 $0.9V$, 设计晶体管的尺寸, 1. 使其在单位增益负反馈时系统性失调小于 $0.1mV$;

2. 使其随机性失调的标准差 (std) 小于 1mV;
3. 使其共模抑制比大于 50dB。

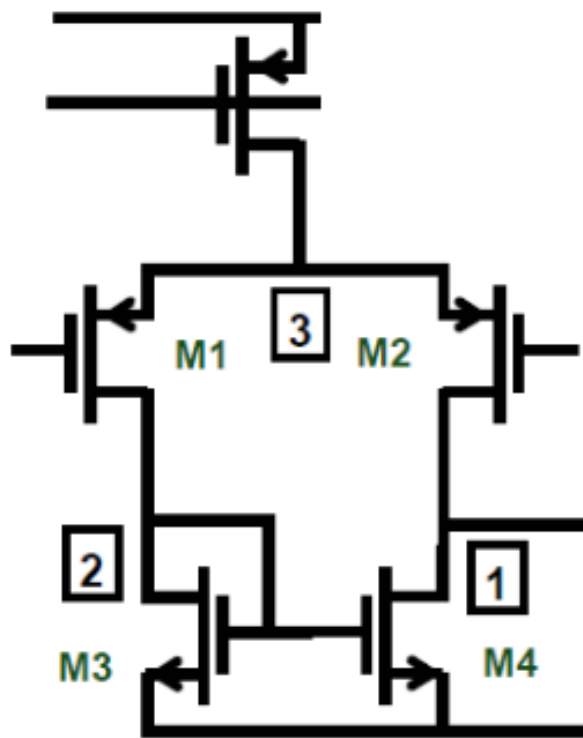


图 1: 作业电路

2 系统性失调

分析 ΔV_{out} :

$$\Delta V_{out} = R_{eq,pmos} * \Delta I_B$$

$$\Delta I_B = \lambda_n \Delta V_{ds,n} I$$

因此, 需要降低 λ , 一般来说, 沟道越长, λ 越小。所以需要尽量增大沟道长度 L 。

3 随机性失调

需要使得 $V_{gs} - V_t$ 尽量小, 因此同样电流下, W/L 更大。而之前一节已经确定需要增大 L , 因此 W 也需要更大。

4 电路搭建

对于已经给定的偏置电流 $100\mu A$ 可以确定各个晶体管通过的电流大小，通过预估 pMOS 与 nMOS 的阈值电压，设置各个晶体管的长宽比。长宽比的设置可以通过 Aether 自带的 DC 扫描计算得到，以 pMOS 为例，搭建电路如 图 2，将参数输入到 MDE 的设置中，如 图 3，得到电流扫描的图像，读取对应电流下的长宽比 k 即可。

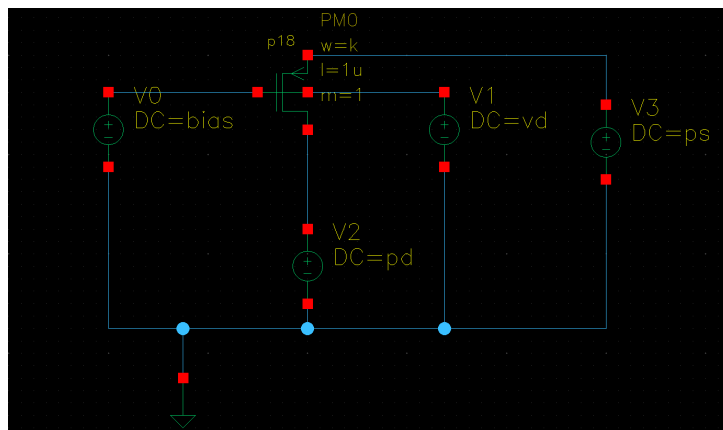


图 2: 扫描 pMOS 长宽比电路

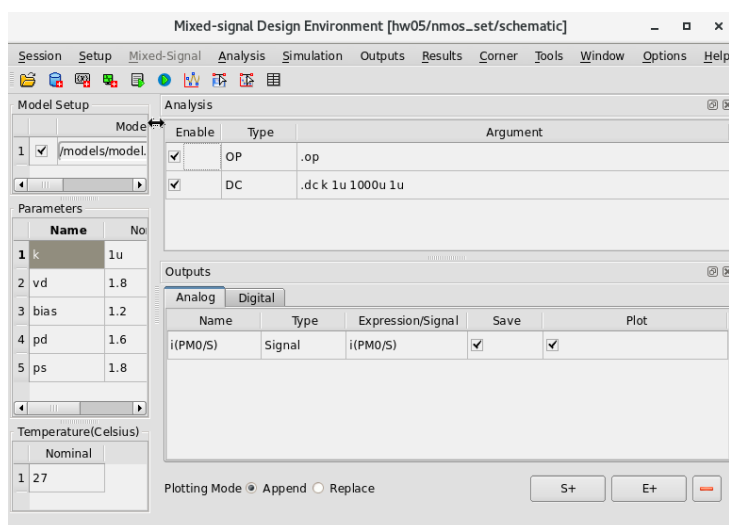


图 3: 扫描 pMOS 长宽比 MDE 设置

根据上述方法，预估好关键电压后，确定 OTA 的各个晶体管尺寸，对差分输入为 $0V$ 时进行 OP 仿真，电流满足需求，如 图 4。

5 系统性失调验证

进一步，通过 cds_thru 连接成单位增益负反馈电路，如图 5，对其输出进行 DC 仿真，其 V_{in} 与原有值的偏离即为系统性失调。经过仿真，如图 6，为 $97\mu V$ ，满足要求。

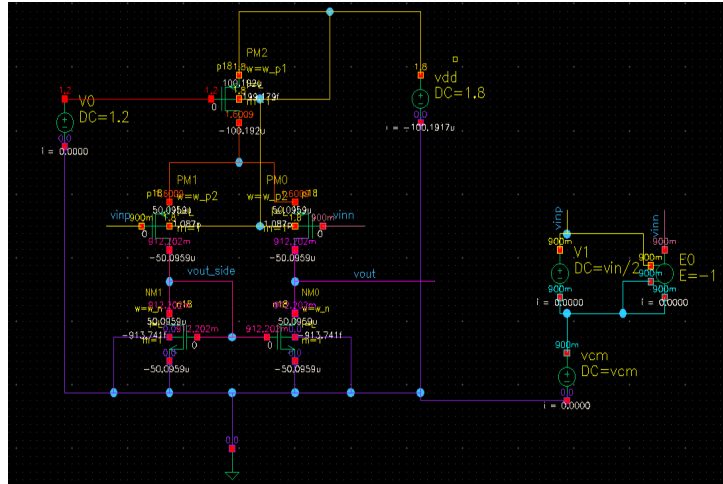


图 4: OTA (未进行单位增益缓冲) 各管状态以及电流大小

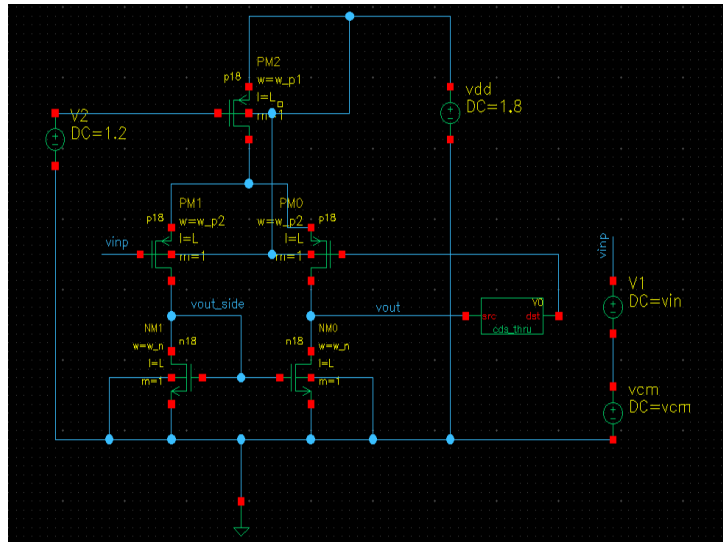


图 5: 单位增益负反馈电路

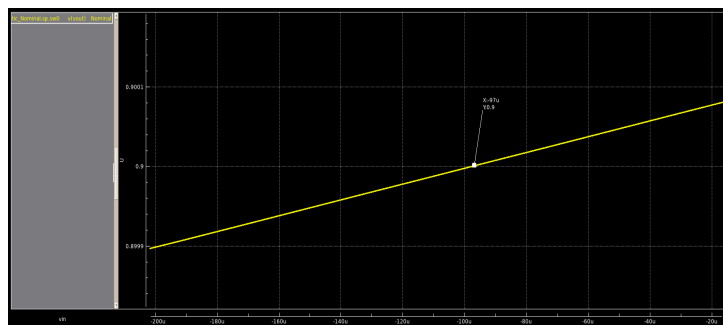


图 6: 系统性失调转换到输入端为 $97\mu V$

6 随机性失调验证

将模型切换到专用的蒙特卡洛模型，并恢复为差分电路。在 DC 仿真下对输入电压进行 400 次随机测试，可以保证最坏在 2σ 范围外，如 图 7，可以得到 $2\sigma < 800\mu$ ，满足要求。

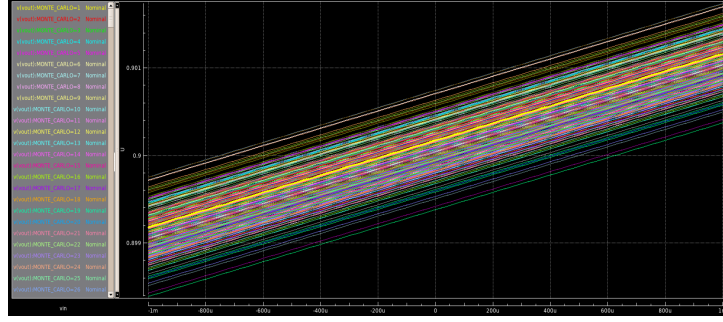


图 7: 蒙特卡洛仿真

7 CMRR 验证

根据公式 $CMRR = A_{v,d}/A_{v,c}$ ，分别对共模输入和差分信号造成的增益进行 AC 仿真，分别如图 8，图 9，可得 $A_{v,d} = 250$, $A_{v,c} = 0.13$ ，那么 $CMRR = 250/0.13 = 1923$ ，转换为分贝数， $10 \times \log 1923 = 75.616DB$ ，满足要求。

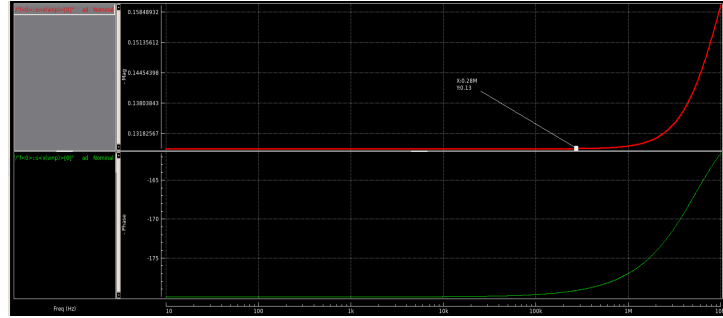


图 8: OTA 共模增益

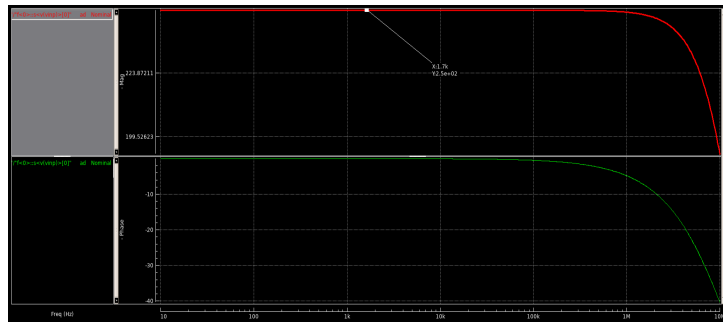


图 9: OTA 差分增益